





	<h2>SI4164DY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4164DY-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4164DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21393 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4164DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	21393 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3545pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













SI4164DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4164DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4164DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4164DY-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI4164DY-T1-E3</b> IOR SI4164DY-T1-E3 IOR	 <b>SI4166DY</b> SI SI4166DY SI	 <b>SI4166DY-T1-E3</b> VISHAY SI4166DY-T1-E3 VISHAY	 <b>SI4166DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 30.5A 8-SOIC
 <b>SI4166DY-T1</b> VISHAY VISHAY SO-8	 <b>SI4162DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 19.3A 8-SOIC	 <b>SI4162DY-T1-E3</b> VISHAY SI4162DY-T1-E3 VISHAY	 <b>SI4162DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 19.3A 8-SOIC

### heiße Teile

Mehr

 SI4134T-BMR	 SI4134T-GMR	 SI4136-F-GM	 SI4136-F-GMR	 SI4136DY-T1-GE3
 SI4136DY-T1-GE3	 SI4136XM-BT	 SI4136XM-GTR	 SI4154DY-T1-GE3	 SI4154DY-T1-GE3
 SI4156DY	 SI4156DY-T1-E3	 SI4156DY-T1-GE3	 SI4156DY-T1-GE3	 SI4160DY
 SI4160DY-T1-E3	 SI4160DY-T1-GE3	 SI4160DY-T1-GE3	 SI4160DY-TI-GE3	 SI4162DY
 SI4162DY-T1-E3	 SI4162DY-T1-GE3	 SI4162DY-T1-GE3	 SI4164DY	 SI4164DY-T1-E3
 SI4164DY-T1-GE3	 SI4166DY	 SI4166DY-T1-E3	 SI4166DY-T1-GE3	 SI4166DY-T1-GE3
 SI4168DY	 SI4168DY-T1-E3	 SI4168DY-T1-GE3	 SI4168DY-T1-GE3	 SI4170DY-T1-GE3
 SI4170DY-T1-GE3	 SI4172DY	 SI4172DY-T1-E3	 SI4172DY-T1-GE3	 SI4172DY-T1-GE3
 SI4174DY	 SI4174DY-T1-E3	 SI4174DY-T1-GE3	 SI4174DY-T1-GE3	 SI4176DY-T1-GE3
 SI4176DY-T1-GE3	 SI4178DY	 SI4178DY-T1-E3	 SI4178DY-T1-E3	 SI4178DY-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited